

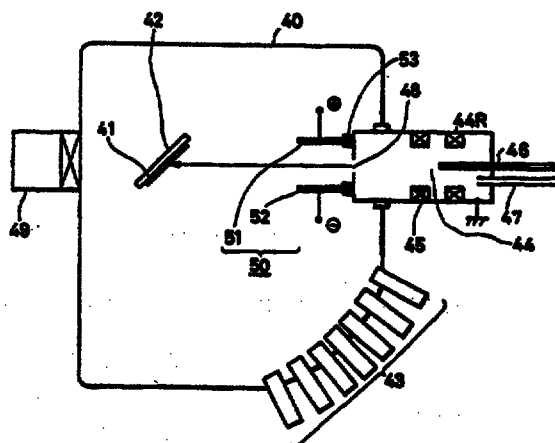


特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 H01L 21/363	A1	(11) 国際公開番号 WO95/34093 (43) 国際公開日 1995年12月14日(14.12.95)
(21) 国際出願番号 PCT/JP95/00854 (22) 国際出願日 1995年4月28日(28.04.95) (30) 優先権データ 特願平6/127634 1994年6月9日(09.06.94) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ソニー株式会社(SONY CORPORATION)[JP/JP] 〒141 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo, (JP) (72) 発明者: および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 伊藤 哲(ITO, Satoshi)[JP/JP] 谷口 理(TANIGUCHI, Satoshi)[JP/JP] 池田昌夫(IKEDA, Masao)[JP/JP] 奥山浩之(OKUYAMA, Hiroyuki)[JP/JP] 塚本弘範(TSUKAMOTO, Hironori)[JP/JP] 長井政春(NAGAI, Masaharu)[JP/JP] 玉村好司(TAMAMURA, Koshi)[JP/JP] 〒141 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo, (JP)	(74) 代理人 弁理士 松隈秀盛(MATSUKUMA, Hidemori) 〒160 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 新宿ビル Tokyo, (JP) (81) 指定国 BR, CN, JP, KR, MX, SG, US, 欧州特許(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). 添付公開書類 国際調査報告書 SG 9600453-6	

(54) Title : METHOD FOR FORMING NITROGEN-DOPED GROUP II-VI COMPOUND SEMICONDUCTOR FILM

(54) 発明の名称 窒素ドーピング II-VI 族化合物半導体の成膜方法



(57) Abstract

When forming a group II-VI compound semiconductor film made of at least one of group II elements and at least one of group VI elements on a substrate, the substrate is exposed to a nitrogen plasma while charged particles contained in the plasma are removed by means of a charged particle removing means so as to dope the film with nitrogen. The activating rate and crystallinity of the film are improved.

基板上に、II族元素のうちの少なくとも1種と、VI族元素のうちの少なくとも1種とからなるII-VI族化合物半導体膜を成膜するに際して、励起状態の窒素プラズマを、荷電粒子排除手段によりプラズマ中の荷電粒子を除去しながら上記基板上に照射し、窒素ドーピングII-VI族化合物半導体の成膜を行って、活性化率の向上、結晶性の向上をはかる。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を特定するために使用されるコード

AM	アルメニア	EE	エストニア	LK	スリランカ	RU	ロシア連邦
AT	オーストリア	ES	スペイン	LR	リベリア	SE	スウェーデン
AU	オーストラリア	FI	フィンランド	LT	リトアニア	SG	シンガポール
BB	バルバドス	FR	フランス	LU	ルクセンブルグ	SI	スロベニア
BE	ベルギー	GB	イギリス	LV	ラトヴィア	SK	スロバキア共和国
BG	ブルガリア	GE	グルジア	MC	モナコ	SS	スウェーデン
BJ	ベナン	GN	ギニア	MD	モルドバ	SZ	スワジランド
BR	ブラジル	GR	ギリシャ	MG	マダガスカル	TD	チャド
BY	ベラルーシ	HU	ハンガリー	ML	マリ	TG	トーゴ
CA	カナダ	IE	アイルランド	MR	モリタニア	TM	トルクメニスタン
CC	中東	IS	イスラエル	MW	マラウイ	TT	トリニダード・トバゴ
CF	中央アフリカ共和国	IT	イタリア	MX	メキシコ	UA	ウクライナ
CG	コンゴ	JP	日本	NE	ニジェール	UG	ウガンダ
CH	スイス	KE	ケニア	NL	オランダ	US	米国
CI	コート・ジボアール	KR	韓国	NO	ノルウェー	UZ	ウズベキスタン共和国
CN	中国	KZ	カザフスタン	NZ	ニュージーランド	VN	ベトナム
CO	コロンビア	LI	リヒテンシュタイン	PL	ポーランド		
CZ	チェコ共和国			PT	ポルトガル		
DE	ドイツ			RO	ルーマニア		
DK	デンマーク						